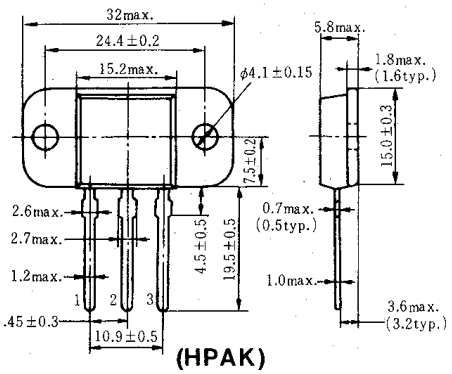
2SK343,2SK344

シリコンNチャネル MOS FET

低周波·高周波電力増幅用
高速度電力スイッチング用
2SJ99, 2SJ100とコンプリメンタリペア

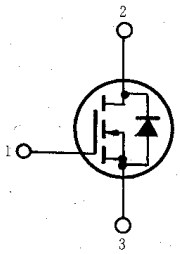
SILICON N-CHANNEL MOS FET

LOW FREQUENCY.HIGH FREQUENCY POWER AMPLIFIER
HIGH SPEED POWER SWITCHING
Complementary pair with 2SJ99. 2SJ100



(HPAK)

1. ゲート：Gate
2. ドレイン：Drain
（フランジ）(Flange)
3. ソース：Source
(Dimensions in mm)

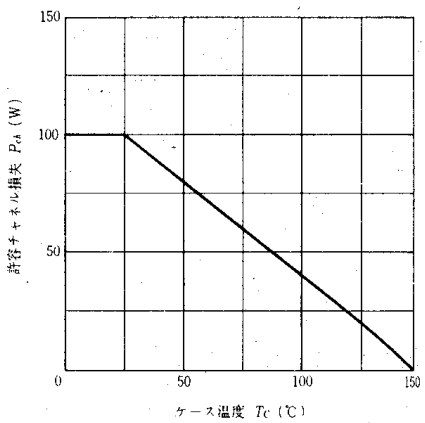


■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25℃)

項目	Symbol	2SK343	2SK345	Unit
ドレイン・ソース電圧	V_{DSS}	140	160	V
ゲート・ソース電圧	V_{GSS}	±20	±20	V
ドレイン電流	I_D	8	8	A
せん頭ドレイン電流	$I_{D(peak)}$	12	12	A
逆ドレイン電流	I_{DR}	8	8	A
許容チャネル損失	P_{ch}*	100	100	W
チャネル温度	T_{ch}	150	150	℃
保存温度	T_{stg}	−55～+150	−55～+150	℃

* T_C=25℃における許容値
* Value at T_C=25℃

許容チャネル損失のケース温度による変化
MAXIMUM CHANNEL DISSIPATION CURVE



■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARCTERISTICS (Ta=25℃)

項目	Symbol	Test Condition	2SK343			2SK344			Unit
			min	typ	max	min	typ	max	
ドレイン・ソース破壊電圧	$V_{(BR)DSS}$	I_D=10mA, V_{GS}=0	140	—	—	160	—	—	V
ゲート遮断電流	I_{GSS}	V_{GS}=±20V, V_{DS}=0	—	—	±1	—	—	±1	μA
ドレイン電流	I_{DSS}	V_{DS}=120V, V_{GS}=0	—	—	1	—	—	—	mA
		V_{DS}=140V, V_{GS}=0	—	—	—	—	—	1	
ゲート・ソース遮断電圧	$V_{GS(off)}$	I_D=1mA, V_{DS}=10V	2.0	—	5.0	2.0	—	5.0	V
ドレイン・ソースオン抵抗	$R_{DS(on)}$	I_D=4A, V_{GS}=15V*	—	0.4	0.5	—	0.4	0.5	Ω
ドレイン・ソース飽和電圧	$V_{DS(on)}$	I_D=4A, V_{GS}=15V*	—	1.6	2.0	—	1.6	2.0	V
順伝達アドミタンス	$\|y_{fs}\|$	I_D=4A, V_{DS}=10V*	1.0	2.0	—	1.0	2.0	—	S
入力容量	C_{iss}	V_{DS}=10V, V_{GS}=0, f=1MHz	—	800	—	—	800	—	pF
出力容量	C_{oss}		—	330	—	—	330	—	pF
逆伝達容量	C_{rss}		—	60	—	—	60	—	pF
ターンオン遅延時間	$t_{d(on)}$	I_D=2A, V_{GS}=15V, R_L=15Ω	—	15	—	—	15	—	ns
立上り時間	t_r		—	35	—	—	35	—	ns
ターンオフ遅延時間	$t_{d(off)}$		—	60	—	—	60	—	ns
下降時間	t_f		—	50	—	—	50	—	ns
ダイオード順電圧	V_{DF}	I_F=4A, V_{GS}=0	—	0.9	—	—	0.9	—	V
逆回復時間	t_{rr}	I_F=4A, V_{GS}=0	—	250	—	—	250	—	ns

* パルス測定
* Pulse Test

HITACHI